

事業概況—設備投資額・研究開発費

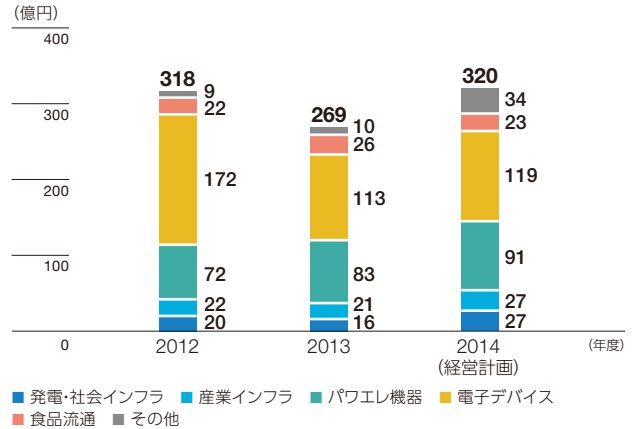
設備投資額

アジア拠点の体制整備、新製品開発と生産能力強化

2013年度は、売上伸長が期待されるパワエレ機器、産業インフラ分野に注力し、タイにアジア・欧米向け製品の供給拠点として新工場を建設し、インバータや無停電電源装置などの生産設備を導入しました。また、スマートメーターの量産化に向け自動化設備の導入を進めました。さらに、次世代パワー半導体SiCデバイスの6インチ生産ラインを新設しました。

今後は、タイ新工場においてパワエレ機器の生産能力増強を図るとともに、産業インフラや食品流通などへ事業領域を拡大し、ガス絶縁開閉装置や自販機の生産設備を導入し、中核拠点としての体制を強化します。また、スマートメーターの受注拡大に向け、自動化設備への投資を加速させます。さらに、次世代パワー半導体開発設備の導入や研究開発棟の建設により、新製品創出に向けた開発力の強化を図ります。

設備投資額



研究開発費

コア技術の徹底強化と新商材開発の加速

富士電機は、パワー半導体やパワーエレクトロニクスなどのコア技術を強化し、特徴あるコンポーネントやシステムの開発を進めるとともに、全社シナジー(熱、機械、制御技術)を発揮する新商材の開発に取り組んでいます。

2013年度は、幅広い産業分野で省エネを実現する次世代パワー半導体SiCデバイスの開発を進め、このSiCパワー半導体を適用したパワーコンディショナなどのパワエレ機器の開発を加速させるため、研究開発費を電子デバイス、パワエレ機器に集中的に投下しました。

今後は、グローバルな事業拡大に向け、研究機関や大学とのオープンイノベーションによる製品開発のスピードアップを図るとともに、現地のニーズに適した商品開発を引き続き推進していきます。具体的には、(独)*産業技術総合研究所とのSiCパワー半導体開発や中国における「浙江大学-富士電機協業センター」の設立などの取り組みを進めていきます。さらに国内3拠点(東京工場・松本工場・吹上工場)で研究開発棟の建設を進め、研究開発体制を強化していきます。

* 独立行政法人

研究開発費

